

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)					電気的特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)										外形	備考
				V_{ceo} (V)	V_{cso} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{cso} 最大値 (μA)	$V_{ce(V)}$	直流又はパルス h_{FE} I_c (mA)	バイアス $V_{ce(V)}$	h_{FE} h_{FE} *	h_{ie} h_{ie} * (Ω)	h_{re} h_{re} * ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe} * (μS)	$f_{\alpha b}$ $f_{\alpha b}$ * (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $r_{bb'}$ (real)* (Ω)	
1	2	3	4	5					6	7	8				9				11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I_{cso} MAXIMUM VALUE AND V_{ce} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{cso})
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{ce} , I_c (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{ce} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

- 9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T .
- 10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11 OUTLINE
- 12 REMARKS

: とコンプリ: COMPLEMENTARY TO

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)													外 形	備 考	
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CB0} 最大値 (μA)	V_{CB} (V)	直 流 又 は パ ル ス h_{FE} V_{CE} (V)	I_C (mA)	V_{CB} (V)	I_E (mA)	h_{fe} h_{fb}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	f_{ab} f_T^* (Mc)	C_{ob} C_{rr}^* (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)				
2SC1655A	日 電	RF.LN	Si.E	16	3	30	150	175	0.1	10	100	3	10	6	-20	$NF < 3\text{dB}$ (6V, 5mA, 500MHz)			8000*	0.5	40*	320		
" 1890A	日 立	AF	"	120	5	50	300	125	0.5	100	250~1200	12	2	12	-2				200*	1.6		138		
" 1913A	松 下	PA	"	180	5	1 A	15W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	180	65~330	10	150	10	-50				120*	<10		268		
" 1965A	三 菱	"	"	40	4	2 A	15W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	500	25	50	10	100			$P_D = 6.5\text{W}$ ($f=175\text{MHz}$, $V_{CE}=13.5\text{V}$, $P_{I0}=0.6\text{W}$)						97B	エミッタ・ ケース接続	
" 2127A	新電元	SW	Si.T	200	6	10A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	250	200	32	3	10A			$t_{on} < 1\mu\text{S}$, $t_f < 0.5\mu\text{S}$ $t_{off} < 2\mu\text{S}$						102		
" 2128A	"	"	"	200	6	30A	200W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	500	200	22	3	30A			$t_{on} < 1\mu\text{S}$, $t_f < 0.5\mu\text{S}$ $t_{off} < 2\mu\text{S}$						266		
2SC631A	ソニー	RF.AF.LN	Si.E	25	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C_{PAB} 350pS	38	25A704 とコンプリ
" 632A	"	RF.LN	"	50	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C_{PAB} 350pS	38	25A705 とコンプリ
" 633A	"	RF.Conv.Mix Osc.SW	"	25	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-2	$t_r < 60\text{nS}$, $t_f < 150\text{nS}$ $t_{off} < 500\text{nS}$			140*	4.5	C_{PAB} 350pS	38	25A677 とコンプリ	
" 634A	"	"	"	50	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-2	$t_r < 60\text{nS}$, $t_f < 150\text{nS}$ $t_{off} < 500\text{nS}$			140*	4.5	C_{PAB} 350pS	38	25A678 とコンプリ	
" 756A	"	RF.PA	Si.Eme	130	6	4 A	10W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	1	50	100	2	100	10	-100				100*	45	C_{PAB} 35pS	181		
" 806A	"	PA	Si.TMe	700	10.5	10A	125W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	5 mA	500	40	3	2 A	10	-500				5.5*	285	5	102		
" 867A	"	RF.PA	"	520	10	3 A	48W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	50	50	80	3	100	10	-200				8.5*	90	12	100		
" 1664A	サンケン	PA	"	100	6	6 A	40W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10	100	1000	4	1 A	10	-500				20*	75	12	99		
" 1741A	東洋電機	AF	Si.EP	50	5	500	400	125	0.5	30	82~390	3	100	5	-20				250*	5		138		
" 1871A	日 電	SW	Si.TMe	500	7	10A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	400	>15	5	5 A			$t_{on} < 1\mu\text{S}$, $t_f < 1\mu\text{S}$ $t_{off} < 2\mu\text{S}$						102		
" 2337A	"	PA.SW	Si.E	150	4.5	10A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	50	150	150	5	1 A	5	-200	$t_{on} = 0.2\mu\text{S}$, $t_{off} = 1.8\mu\text{S}$ $t_{off} = 1.5\mu\text{S}$			70*	150		102	25A1007A とコンプリ	
" 2516A	"	SW	"	150	12	5 A	30W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10	80	40~200	5	3 A			$t_{on} < 0.5\mu\text{S}$, $t_f < 0.5\mu\text{S}$ $t_{off} < 1.5\mu\text{S}$					268	25A1069A とコンプリ		
" 1627A	東 芝	AF.PA	"	80	5	400	800	150	0.1	50	70~240	2	50	10	-10				100*	10		241	25A817A とコンプリ	
" 1708A	三 菱	AF.LN.RF	Si.EP	120	5	50	200	125	0.1	70	250~1200	6	1	6	-1	$V_{CE0} < 170\text{mV}$ (10V, 1mA, $R_C = 100k\Omega$, $A_0 = 80\text{dB}$)			150*	1.8		138B	25A847A とコンプリ	
" 1914A	"	AF.RF	"	120	5	50	200	125	0.1	70	250~1200	6	1	6	-1				150*	1.8		138B		
" 2126A	新電元	SW	Si.T	200	6	3 A	30W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	250	200	42	3	3 A			$t_{on} < 1\mu\text{S}$, $t_f < 1\mu\text{S}$ $t_{off} < 2\mu\text{S}$						204		
" 2139A	東 芝	"	"	500	6	10A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	400	>20	5	5 A			$t_r < 1\mu\text{S}$, $t_f < 1\mu\text{S}$ $t_{off} < 2.5\mu\text{S}$						102		
" 2230A	"	PA	"	200	5	100	800	150	0.1	200	120~400	10	10	10	-10				>50*	<7		241		
" 2231A	"	"	"	200	5	200	12W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	0.1	200	100~320	10	50	10	-50				>50*	<10		178		
" 2238A	"	"	Si.E	180	5	1.5A	25W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1	160	70~240	5	100	10	-100				100*	25		268	25A968A とコンプリ	
" 2238B	"	"	"	200	5	1.5A	25W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1	160	70~240	5	100	10	-100				100*	25		268	25A968B とコンプリ	